
	<p><b>SI2323DS-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2323DS-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2323DS-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 170100 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2323DS-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	170100 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1020pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)






SI2323DS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2323DS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2323DS-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2323DS-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2323DDS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A SOT-23</p>	 <p><b>SI2323DS</b> VISHAY SI2323DS VISHAY</p>	 <p><b>SI2323DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2323DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>
 <p><b>SI2323DS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2323DDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A SOT-23</p>	 <p><b>SI2323DS-T1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23</p>	 <p><b>SI2323DS-TI-E3</b> VIS VIS SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|  SI2319CDS-T1-E3 |  SI2319CDS-T1-GE3 |  SI2319CDS-T1-GE3 |  SI2319DDS-T1-GE3 |  SI2319DS         |
|  SI2319DS-T1-E3  |  SI2319DS-T1-E3   |  SI2319DS-T1-GE3  |  SI2319DS-T1-GE3  |  SI2320DS         |
|  SI2320DS-T1-E3  |  SI2320DS-T1-GE3  |  SI2321DS-T1-E3   |  SI2321DS-T1-E3   |  SI2321DS-T1-GE3  |
|  SI2321DS-T1-GE3 |  SI2323CDS-T1     |  SI2323CDS-T1-E3  |  SI2323CDS-T1-GE3 |  SI2323CDS-T1-GE3 |
|  SI2323DDS-T1-E3 |  SI2323DDS-T1-GE3 |  SI2323DDS-T1-GE3 |  SI2323DS         |  SI2323DS-T1-E3   |
|  SI2323DS-T1-GE3 |  SI2323DS-T1-GE3  |  SI2324DS-T1-E3   |  SI2324DS-T1-GE3  |  SI2324DS-T1-GE3  |
|  SI2325DS-T1-E3  |  SI2325DS-T1-E3   |  SI2325DS-T1-GE3  |  SI2325DS-T1-GE3  |  SI2327DS-T1-E3   |
|  SI2327DS-T1-E3  |  SI2327DS-T1-GE3  |  SI2327DS-T1-GE3  |  SI2328DS         |  SI2328DS-T1      |
|  SI2328DS-T1-E3  |  SI2328DS-T1-E3   |  SI2328DS-T1-GE3  |  SI2328DS-T1-GE3  |  SI2329DS-T1-E3   |
|  SI2329DS-T1-GE3 |  SI2329DS-T1-GE3  |  SI2331DS         |  SI2331DS-T1-E3   |  SI2331DS-T1-E3   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited